

a 2008 0129

Invenția se referă la dispozitivele semiconductoare, în particular la detectori de gaze și poate fi utilizată pentru detectarea gazelor toxice în atmosferă.

Detectorul de gaze în baza semiconductorilor halcogenici sticloși conține un suport izolant, pe care sunt amplasate consecutiv un strat sensibil la gaze în baza unui semiconductor halcogenic sticlos, obținut prin metoda evaporării în vid de As_2S_3 , As_2Se_3 sau a soluțiilor lor solide, și doi electrozi. Totodată stratul sensibil la gaze are o suprafață reliefată cu o periodicitate strictă, executată sub formă de rețea de difracție prin metoda holografică.

Revendicări: 1

Figuri: 3